



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 14 953.4

Anmeldetag: 04. April 2002

Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG, 81669 München/DE

Bezeichnung: Leistungsmodul mit mindestens zwei Substraten
und ein Verfahren zu seiner Herstellung

IPC: H 01 L, H 05 K

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 19. Oktober 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Kahle

FIN 391 P/200202064

1



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Leistungsmodul mit mindestens zwei Substraten und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

5

Um intelligente Leistungsmodul zu schaffen, werden zunehmend Logikschaltungen und passive Bauelemente neben den Leistungsbau-
elementen in Hybridbauweise in einem Leistungsmodul integriert. Mit zunehmender Zahl von Signalhalbleiterchips auf
10 der Substratfläche wird der Bedarf an teurer Substratkeramik ständig größer, so dass die Kosten für intelligente Leistungsmodul ständig steigen. Diese Kosten können auch nicht dadurch vermindert werden, dass mehrere Substrate übereinander gestapelt werden, zumal die Stütz- und Verbindungstechnik
15 bei gestapelten Strukturen ebenfalls die Kosten in die Höhe treibt.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Leistungsmodul anzugeben, das sowohl Leistungshalbleiterchips als auch Signalhalbleiterchips aufweist, das einfach und preiswert herzustellen ist
20 und den Flächenbedarf für ein Substrat mit Halbleiterchips trotz zusätzlicher Signalhalbleiterchips nicht vergrößert.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
25

Erfindungsgemäß wird ein Leistungsmodul mit einem ersten Substrat, das mit Leitungshalbleiterchips bestückt ist und einem
30 zweiten Substrat, das mit Signalhalbleiterchips bestückt ist, geschaffen. Dabei sind die Substrate in dem Leistungsmodul parallel übereinander ausgerichtet und ihre Bestückungsseiten zueinander angeordnet. Die beiden Bestückungsseiten sind

elektrisch miteinander über scharnierartig gebogene Bonddrähte verbunden, wobei die Bonddrähte gleichzeitig den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat definieren und mechanisch das zweite Substrat über dem ersten Substrat in
5 einem Kunststoffgehäuse fixieren.

Ein derartiges Leistungsmodul hat den Vorteil, dass für die Leistungshalbleiterchips ein entsprechend wärmefestes und wärmeleitendes Substrat vorgesehen werden kann, während für
10 die Signalhalbleiterchip ein weitaus preiswerteres Substrat, das keine große Wärmebelastung erfährt, eingesetzt werden kann. Durch die scharnierartig gebogenen Bonddrähte entfällt weiterhin eine komplexe Stützmechanik, um den Abstand zwischen den beiden Substraten zu definieren, vielmehr kann das
15 zweite Substrat mit Hilfe der scharnierartig gebogenen Bonddrähte in einem definierten Abstand von dem ersten Substrat gehalten werden, wobei sich die beiden Bestückungsseiten gegenüberstehen. Die scharnierartig gebogenen Bonddrähte bilden außerdem eine mechanische Fixierung der Position des zweiten
20 Substrats über dem ersten Substrat und beide Substrate einschließlich ihrer Halbleiterchips können in diesem über scharnierartig gebogene Bonddrähte definierten Zustand in eine Kunststoffmasse eingebettet sein.

25 Das mit Leistungshalbleiterchips bestückte Substrat kann eine Keramikplatte aufweisen, die einerseits eine gute Wärmeableitung ermöglicht und andererseits eine hohe Temperatur- bzw. Wärmefestigkeit aufweist. Damit wird gewährleistet, dass die Leistungshalbleiterchips ihre volle Verlustwärme über die Keramikplatte abführen können. Zur Verbesserung der Wärmeabfuhr
30 kann die Keramikplatte auf einer Wärmesenke aus einer Kupferplatte montiert sein. Um möglichst viele Funktionen mit einer derartigen Keramikplatte zu realisieren kann das mit Lei-

stungshalbleiterchips bestückte Substrat eine mehrlagige Keramikplatte aufweisen. In einer derartigen mehrlagigen Keramikplatte wechseln sich isolierende Lagen mit metallischen Strukturen ab, wobei die metallischen Strukturen der einzelnen Metall-Lagen über Durchkontakte durch die Isolationslagen untereinander verbunden sind.

Für die geringe Verlustleistung erzeugenden Signalhalbleiterchips ist ein zweites Substrat vorgesehen, das eine Leiterplatte aus glasfaserverstärktem Kunststoff aufweist. Dieser glasfaserverstärkte Kunststoff kann auf das Aufdehnungsverhalten des Halbleiterchips abgestimmt sein. Insbesondere durch die Ausrichtung der Glasfasern in x- und y-Richtung kann das mit Signalhalbleiterchips bestückte Substrat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, der annähernd dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten eines Halbleiterchips wie Silicium entspricht. In z-Richtung kann jedoch der thermische Ausdehnungskoeffizient des zweiten Substrats für die Signalhalbleiterchips einen für Kunststoff üblichen Wert aufweisen, da in z-Richtung dem Substrat für die Signalhalbleiterchips keine thermischen Ausdehnungsbeschränkungen auferlegt werden müssen.

Bei dichter Bestückung des zweiten Substrats mit Signalhalbleiterchips kann es vorteilhaft sein, dass als zweites Substrat eine mehrlagige Leiterplatte aus glasfaserverstärktem Kunststoff eingesetzt wird. Ein derartiges zweites Substrat aus einer glasfaserverstärkten Leiterplatte kann Logikhalbleiterbauteile, Signalhalbleiterchips, integrierte Steuerungsschaltungen, integrierte Treiberschaltungen oder auch Temperatursensoren die Einsatzmöglichkeiten des Leistungsmoduls erweitern.

Das mit Signalhalbleiterchips bestückte zweite Substrat kann darüber hinaus passive Komponenten, wie Widerstände, Kondensatoren oder Induktivitäten aufweisen, die sowohl in Dünnschichttechnik als auch in Dickfilmtechnik auf der Leiterplatte des zweiten Substrats realisierbar sind.

Im Gegensatz zu dem zweiten Substrat aus einer Leiterplatte mit Signalhalbleiterchips, die nur geringe Verlustwärme entwickeln, sind auf dem ersten Substrat Leistungshalbleiterchips, wie bipolare Leistungstransistoren mit isoliertem Gate, angeordnet, die eine hohe Verlustleistung aufweisen und diese Verlustleistung über eine entsprechend gut wärmeleitende Keramikplatte als Substrat an die Umgebung abgeben. Anstelle von bipolaren Leistungstransistoren kann das erste Substrat auch Leistungshalbleiterchips als Metalloxid-Leistungsfeldeffekttransistoren aufweisen. Diese, abgekürzt MOS-Leistungstransistoren entwickeln ebenfalls eine hohe Verlustwärme, so dass eine Keramikplatte als erstes Substrat für diese Leistungshalbleiterchips geeignet erscheint. Ein weiterer Vorteil von Keramikplatten für derartige Leistungshalbleiterchips ist, dass Keramikplatten mit ihrem thermischen Ausdehnungskoeffizienten relativ genau an den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Halbleitermaterials angepaßt werden kann. Somit entstehen trotz erheblicher Verlustwärmeentwicklung keine erheblichen thermischen Spannungen zwischen den Leistungshalbleiterchips und dem ersten Substrat.

Zur Schaffung intelligenter Leistungsmodule sollen die Signalhalbleiterchips auf der zweiten Halbleiterplatte mit den Leistungshalbleiterchips auf dem ersten Substrat elektrisch zusammenwirken. Dieses wird über Leiterbahnen auf dem zweiten Substrat mit Signalhalbleiterchips und den scharnierartig ge-

FIN 391 P/200202064

5

bogenen Bonddrähten, die mit entsprechenden Leiterbahnen auf dem ersten Substrat in Verbindung stehen, erreicht.

Die scharnierartig gebogenen Bonddrähte können Aluminium und/oder eine Aluminiumlegierung aufweisen und haben eine Mindestdicke von 100 Mikrometer, um die mechanische Festigkeit beziehungsweise den definierten Abstand zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat zu halten. Aufgrund der Verarbeitbarkeit von Aluminiumbonddrähten liegt die obere Grenze für den Durchmesser der Aluminiumbonddrähte bei etwa 300 Mikrometer.

Ein Verfahren zur Herstellung eines Leistungsmoduls mit einem ersten Substrat, das mit Leistungshalbleiterchips bestückt ist und einem zweiten Substrat, das mit Signalhalbleiterchips bestückt ist, weist folgende Verfahrensschritte auf:

Zunächst wird ein erstes Substrat, das mit Leistungshalbleiterchips bestückt ist und ein zweites Substrat, das mit Signalhalbleiterchips bestückt ist, bereitgestellt. Diese beiden Substrate werden so zueinander ausgerichtet, dass ihre Bestückungsseiten benachbart nebeneinander angeordnet sind und Bondflächen aufweisende Randbereiche der Bestückungsseiten beider Substrate nebeneinander liegen. Dazu sind die Bondflächen auf den Randbereichen in einer Zeile nebeneinander angeordnet. Nach dem Ausrichten werden die Substrate an dem Bondflächen aufweisenden Randbereich mit Bonddrähten verbunden, die scharnierartig nebeneinander angeordnet werden.

Nach dem Herstellen aller Bondverbindungen in den Randbereichen des ersten und zweiten Substrats wird das zweite Substrat um 180° unter Verbiegen der scharnierartig angeordneten Bonddrähte umgeklappt, so dass die Substrate parallel über-

einander ausgerichtet und ihre Bestückungsseiten zueinander angeordnet sind. Abschließend werden die derart angeordneten Substrate zu Leistungsmodulen in einem Kunststoffgehäuse verpackt.

5

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass mit dem Herstellen der Bondverbindungen zwischen zwei in Zeilen angeordneten Bondflächenzeilen in den Randbereichen der beiden Substrate eine einfache Lösung gefunden ist, die einerseits preiswert zu realisieren ist, andererseits keine teure Substratfläche für Leistungshalbleiter verbraucht und schließlich voll automatisierbar ist. Auch das Umklappen des zweiten Substrats über das erste über Verbiegen der scharnierartig angeordneten Bondverbindungen zwischen den beiden Substraten kann mit Unterstützung eines Vakuumwerkzeuge automatisiert durchgeführt werden. Abschließend können die Substrate mit den Leistungshalbleiterchips und den Signalhalbleiterchips in einem Kunststoffgehäuse verpackt werden.

10

15

20

25

30

Zum Bereitstellen eines ersten Substrats mit Leistungshalbleiterchips wird zunächst eine Keramikplatte mit einer Leiterbahnstruktur beschichtet. In einem Randbereich dieser Leiterbahnstruktur wird eine Zeile nebeneinander unter vorgegebenem Rastermaß angeordneter Bondflächen vorgesehen. Danach werden auf dem ersten Substrat die Leistungshalbleiterchips angeordnet und untereinander sowie mit der Leiterbahnstruktur über Bonddrähte unter Freilassung der Bondflächenzeile verbunden. Schließlich können auf der Keramikplatte innere Flachleiterenden an dafür vorgesehenen Leiterbahnen der Leiterbahnstruktur angeordnet werden, wobei diese Flachleiterenden zu Außenflachleitern gehören, die einerseits mit Versorgungsspannungen verbunden werden können und andererseits für das Anlegen und Abgreifen von Signalen vorgesehen sind.

Zum Bereitstellen eines zweiten Substrats mit Signalhalbleiterchips wird eine Leiterplatte mit einer Leiterbahnstruktur versehen, die in einem Randbereich eine Zeile nebeneinander angeordneter Bondflächen aufweist, deren Anzahl und Rastermaß der Bondflächenzeile des ersten Substrats entspricht. Auf der Leiterbahnstruktur können dann die Signalhalbleiterchips angeordnet werden und über Bonddrähte unter Freilassung der Bondflächenzeile verbunden werden. Da das Substrat für die Signalhalbleiterchips eine Leiterplatte ist, können relativ preiswert beliebig viele Signalhalbleiterchips auf der Leiterplatte untergebracht werden. Diese Signalhalbleiterchips können Logikschaltungen, Sensorschaltungen, passive Bauelemente, Treiberschaltungen und andere Steuerschaltungen aufweisen.

Als Sensorschaltungen werden bevorzugt Temperatursensoren eingesetzt, um beispielsweise das Leistungsmodul thermisch zu überwachen. Vor einem Verbinden der beiden Substrate über entsprechend scharnierartig angeordnete Bonddrähte werden die beiden Substrate derart zueinander ausgerichtet, dass die Bondflächenzeilen der Substrate nebeneinander angeordnet sind. Somit ist mit einer einfachen und preiswerten Bondverbindungstechnik ein elektrisches und mechanisches Verbinden der beiden zueinander ausgerichteten Substrate auf den aufeinander angepaßten Bondflächen möglich.

Das Verbinden kann mittels Thermokompressions-Sonicbonden von Aluminium und/oder Aluminiumlegierungsbonddrähten erfolgen, wobei diese Bonddrähte einen Durchmesser aufweisen, der mindestens 100 Mikrometer beträgt, um die mechanische Stabilität zu gewährleisten. Aufgrund der üblichen Bondwerkzeuge ist

dieser Durchmesser nach oben hin begrenzt und sollte 300 Mikrometer nicht übersteigen.

Mittels eines Vakuumwerkzeugs kann dann vollautomatisch das
5 Umklappen des zweiten Substrats um 180° unter Verbiegen der
scharnierartig angeordneten Bonddrähte erfolgen, so dass die
Substrate parallel übereinander ausgerichtet sind und ihre
Bestückungsseiten zueinander angeordnet sind. Auf diese Weise
wird gleichzeitig eine sehr kompakte Anordnung aus zwei mit
10 Halbleiterchips bestückten Substraten für ein Leistungsmodul
geschaffen. Diese kompakte Anordnung der beiden Substrate
kann anschließend in einem Kunststoffgehäuse mittels Spritz-
gußtechnik unter Einbetten der übereinander angeordneten Sub-
strate in eine Kunststoffgehäusemasse erfolgen.

15 Eine weitere Möglichkeit das Leistungsmodul zu verpacken be-
steht darin, die beiden aufeinandergeklappten Substrate in
einem vorgefertigten Kunststoffgehäuse anzuordnen und an-
schließend die Hohlräume zwischen den Substraten und dem vor-
20 gefertigten Kunststoffgehäuse mit Siliconmasse aufzufüllen.
Vor dem Anordnen eines Kunststoffgehäuses über den beiden
Substraten kann das erste Substrat, auf dem die Leistungs-
halbleiterchips angeordnet sind auf einer Metallplatte, die
vorzugsweise Kupfer oder eine Kupferlegierung aufweist, mon-
25 tiert werden. Diese Metallplatte bildet einerseits eine Au-
ßenwand für das Kunststoffgehäuse und andererseits eine wir-
kungsvolle Wärmesenke für die Verlustwärme.

Nach dem Verpacken des Leistungsmoduls in einem Kunststoffge-
30 häuse ragen Außenflachleiter aus dem Kunststoffgehäuse her-
aus, die einerseits mit den Leistungshalbleiterchips und an-
dererseits über die scharnierförmig gebogenen Bonddrähte mit
den Signalhalbleiterchips elektrisch verbunden sind. Die

Querschnitte dieser Außenflachleiter können der Leistungsaufnahme für die Leistungshalbleiterchips angepaßt sein und einen größeren Querschnitt aufweisen als Außenflachleiter, die für die Leistungshalbleiterchips bereitgestellt werden.

5

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsformen mit Bezug auf die beiliegenden Figuren näher erläutert.

10 Figur 1 zeigt eine schematische, teilweise aufgebrochene, perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

Figuren

15 2 bis 6 zeigen Prinzipskizzen von Ergebnissen und Zwischenprodukten eines Verfahrens zur Herstellung eines Leistungsmoduls gemäß weiterer Ausführungsformen der Erfindung,

20 Figur 2 zeigt ein Keramiksubstrat mit Leistungshalbleiterchips und einer Reihe von Außenflachleitern für eine Leistungsübertragung und eine weitere Reihe von Außenflachleitern für eine Signalübertragung,

25 Figur 3 zeigt eine Prinzipskizze mit einem ersten Substrat, auf dem Leistungshalbleiterchips angeordnet sind und einem zweiten Substrat, das Signalhalbleiterchips aufweist, wobei die Substrate über scharnierartige Bonddrähte miteinander verbunden sind.

30 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Leistungsmodul vor und nach dem Umklappen des zweiten Substrats,

Figur 5 zeigt eine perspektivische Prinzipskizze eines Leistungsmoduls mit umgeklapptem zweiten Substrat,

5 Figur 6 zeigt eine perspektivische Prinzipskizze eines Leistungsmoduls einer weiteren Ausführungsform der Erfindung,

Figur 1 zeigt eine schematische, teilweise aufgebrochene, perspektivische Ansicht eines Leistungsmoduls 3 einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Das Bezugszeichen 1 kennzeichnet eine Keramikplatte, die als Substrat 1 nicht gezeigte Leistungshalbleiterchips aufweist. Das Bezugszeichen 2 kennzeichnet ein zweites Substrat, das eine Leiterplatte 11 aus glasfaserverstärktem Kunststoff aufweist und über scharnierartig gebogene Bonddrähte 9 über das erste Substrat 1 geklappt ist. Das Bezugszeichen 7 kennzeichnet die Bestückungsseite des ersten Substrats und das Bezugszeichen 8 kennzeichnet die Bestückungsseite des zweiten Substrats.

20 Die beiden Bestückungsseiten 7 und 8 sind einander zugewandt, da die beiden Substrate übereinandergeklappt in dem Kunststoffgehäuse 18 angeordnet sind. In dieser Ausführungsform der Erfindung sind vier Außenflachleiter 27 für die Leistungsversorgung der Leistungshalbleiterchips auf dem ersten Substrat 1 mit ihren inneren Flachleiterenden angeordnet und ragen vertikal aus dem Kunststoffgehäuse 18 heraus. Horizontal ragen fünf Außenflachleiter 28 für Signalübertragungen aus dem Kunststoffgehäuse heraus und sind mit ihren inneren Flachleiterenden auf dem Keramiksubstrat befestigt und über die Bonddrähte 9 elektrisch mit den Signalhalbleitern auf dem zweiten Substrat 2 verbunden.

Die scharnierartig gebogenen Bonddrähte 9 sind in einem vorgegebenen Rastermaß auf einer Bondflächenzeile 19 in dem Randbereich 17 der Keramikplatte 10 des ersten Substrats 1 angeordnet. Die Keramikplatte 10 ist auf einer Metallplatte 5 25 montiert, die in dieser Ausführungsform der Erfindung als Wärmesenke dient und eine Außenwand 26 des Kunststoffgehäuses 18 bildet. Das Kunststoffgehäuse 18 besteht aus einem vorgefertigten Kunststoffgehäuseteil 22, der auf die Metallplatte 25 aufgesetzt ist, und der Hohlraum 23 zwischen dem vorgeformten Kunststoffgehäuse 22 und den Substraten 1 und 2 wird 10 nach dem Aufsetzen auf die Metallplatte mit einer Siliconmasse vergossen.

Mit diesem Aufbau läßt sich preiswert und kompakt ein Leistungsmodul realisieren, das seine Sensoren, Logikschaltungen, Steuerschaltungen und/oder Treiberschaltungen auf dem zweiten Substrat 2 angeordnet hat und auf dem intensiv gekühlten ersten Substrat 1 die Leistungshalbleiterchips in Form MOS-Leistungstransistoren oder bipolaren Leistungstransistoren mit isoliertem Gate oder Leistungsdiolen aufweist. 20

Die Figuren 2 bis 6 zeigen Prinzipskizzen von Ergebnissen und Zwischenprodukten eines Verfahrens zur Herstellung eines Leistungsmoduls gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung. Komponenten der Figuren 2 bis 6 mit gleichen Funktionen 25 wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Figur 2 zeigt ein Keramiksubstrat 1 mit Leistungshalbleiterchips 4 und einer Reihe von Außenflächleitern 27 für eine Leistungsübertragung und eine weitere Reihe mit Außenkontakten 28 für Signalübertragungen. Dabei weisen die Außenflächleiter 28 für Signalübertragungen einen kleineren Querschnitt 30

auf als die Außenflachleiter 27 für Leistungsübertragung. Auf der Keramikplatte 10 sind Leistungsdioden 29 und Leistungstransistoren 30 angeordnet, die über Bondverbindungen 13 untereinander und mit einer nicht gezeigten Leiterbahnstruktur verbunden sind.

Eine Zeile 19, die im Randbereich 17 des Keramiksubstrats 10 angeordnet ist, weist Bondflächen 16 auf, die von Bondverbindungen 13 freigehalten sind. Diese Bondflächen 16 stehen jedoch mit der nicht gezeigten Leiterbahnstruktur elektrisch in Verbindung. Außerdem stehen diese Bondflächen teilweise mit den Außenflachleitern 28 für Signalübertragungen über die Leiterbahnstruktur auf dem Keramiksubstrat 10 elektrisch in Verbindung.

Figur 3 zeigt eine Prinzipskizze mit einem ersten Substrat 1, auf dem Leistungshalbleiterchips 4 angeordnet sind und mit einem zweiten Substrat 2, das Signalhalbleiterchips aufweist, wobei die Substrate 1 und 2 über scharnierartige Bonddrähte 9 miteinander mechanisch und elektrisch verbunden sind. Das zweite Substrat 2 aus einer glasfaserverstärkten Leiterplatte 11 kann Logikchips 12, Steuer- oder Treiberchips 31 und/oder Temperatursensorchips 32 aufweisen, um ein intelligentes Leistungsmodul zu schaffen. Dieses zweite Substrat 2 weist eine nicht im Detail gezeigte Leiterbahnstruktur auf, die mit den Signalhalbleiterchips 5 über Bonddrähte 33 elektrisch verbunden ist. Dabei wird eine Zeile 20 von Bondflächen 16 von internen Bonddrähten 13 des Substrats 2 freigehalten.

Die Bondflächenzeile 20 im Randbereich 17 des Substrats 2 ist derart ausgerichtet, dass sie parallel zu der Bondflächenzeile 19 des Substrats 1 angeordnet ist. Mit einem preiswerten Bondverfahren können somit scharnierartige Bonddrähte 9 aus

Aluminium mit einem Minstdurchmesser von 100 Mikrometer die Bondflächen 16 der Bondzeile 20 mit den Bondflächen 16 der Bondzeile 19 verbinden, so dass das Keramiksubstrat 10 mit der Leiterplatte 11 scharnierartig verbunden ist. Die Bond-
5 drähte 9 bilden nicht nur ein mechanisches Scharnier, sondern dienen gleichzeitig der elektrischen Verbindung zwischen der Leiterbahnstruktur des Keramiksubstrats 10 und der Leiterbahnstruktur der Leiterplatte 11.

10 Figur 4 zeigt eine perspektivische Prinzipskizze eines Leistungsmoduls 3 mit umgeklapptem zweiten Substrat 2. Der Vorgang des Umklappens des zweiten Substrats 2 über das erste Substrat 1 wird in vier Positionen dargestellt, wobei die Pfeile A, B und C die Umklappbewegung für das zweite Substrat
15 2 darstellen. Bei diesem Umklappen verbiegen sich die Bonddrähte 9 scharnierartig und aufgrund ihrer Steifheit nach dem Verbiegen definieren sie den Abstand d zwischen dem ersten Substrat 1 und dem zweiten Substrat 2. Vor dem Umklappen sind die Bondflächen 16 in den Randbereichen 17 der beiden Substrate 1 und 2 derart angeordnet, dass mit einem Bondwerkzeug der Bonddraht 9 sicher auf den Bondflächen 16 befestigt werden kann.
20

Das Umklappen kann mit Hilfe eines Vakuumwerkzeugs automatisch durchgeführt werden. Die Außenflächleiter 28 für eine
25 Signalübertragung sind elektrisch über die Leiterbahnstruktur 34, die Bondflächen 16 und die scharnierartig gebogenen Bonddrähte 9 mit den Signalhalbleiterchips 6 des zweiten Substrats 2 elektrisch verbunden. Die Außenflächleiter 27, die
30 ebenfalls auf dem Keramiksubstrat 10 mit ihren inneren Flachleiterenden 14 fixiert sind, sind über die Leiterbahnstruktur 34 und die Bondverbindungen 13 mit den Leistungshalbleiterchips 4 elektrisch verbunden. Mit der gestrichelten Linie 35

werden in Figur 4 die Umrisse einer Kunststoffgehäusemasse 21 dargestellt, die nach dem Umklappen des zweiten Substrats 2 aufgebracht werden kann.

- 5 Figur 5 zeigt eine perspektivische Prinzipskizze eines Leistungsmoduls 3 mit umgeklapptem zweiten Substrat 2. Die Kunststoffgehäusemasse ist in der Darstellungsform der Figur 5 weggelassen, um die relativ flache Anordnung der beiden Substrate 1 und 2 übereinander zu demonstrieren. Somit kann
10 mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ein kompaktes Leistungsmodul hergestellt werden, das ohne aufwendige Stützstrukturen und Verbindungsstrukturen zwischen den beiden Substraten 1 und 2 auskommt und dennoch ein Leistungsmodul 3 bildet, das mit intelligenter Steuerungs- und Logiktechnik ausgestattet
15 ist.

- Figur 6 zeigt eine perspektivische Prinzipskizze eines Leistungsmoduls 3 einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, wobei mit den gestrichelten Linien 35 die Umrisse des Kunststoffgehäuses 18 gezeigt werden. Diese Ausführungsform der
20 Erfindung nach Figur 6 unterscheidet sich von der Ausführungsform nach Figur 1 dadurch, dass sowohl die Außenflachleiter 27 für eine Leistungsübertragung als auch die Außenflachleiter 28 für eine Signalübertragung horizontal aus dem
25 Kunststoffgehäuse 18 herausragen.

FIN 391 P/200202064

1

Bezugszeichenliste

- | | | |
|----|----|--|
| | 1 | erstes Substrat |
| | 2 | zweites Substrat |
| 5 | 3 | Leistungsmodul |
| | 4 | Leistungshalbleiterchip |
| | 5 | Signalhalbleiterchip |
| | 6 | Halbleiterchip |
| | 7 | Bestückungsseite des ersten Substrats |
| 10 | 8 | Bestückungsseite des zweiten Substrats |
| | 9 | scharnierartig gebogene Bonddrähte |
| | 10 | Keramikplatte |
| | 11 | Leiterplatte |
| | 12 | Logikhalbleiterbauteil |
| 15 | 13 | Bonddrähte (allgemein) |
| | 14 | innere Flachleiterenden |
| | 15 | Außenflachleiter |
| | 16 | Bondflächen |
| | 17 | Randbereiche der Substrate |
| 20 | 18 | Kunststoffgehäuse |
| | 19 | Bondflächenzeile des ersten Substrats |
| | 20 | Bondflächenzeile des zweiten Substrats |
| | 21 | Kunststoffgehäusemasse |
| | 22 | vorgefertigtes Kunststoffgehäuse |
| 25 | 23 | Hohlräume zwischen vorgefertigtem Kunststoffgehäuse und Substrat |
| | 24 | Siliconmasse |
| | 25 | Metallplatte |
| | 26 | Außenwand |
| 30 | 27 | Außenflachleiter für Leistungsversorgung |
| | 28 | Außenflachleiter für Signale |
| | 29 | Leistungsdiode |
| | 30 | Leistungs transistor |

- 31 Treiber- oder Steuerchip
- 32 Temperatursensorchip
- 33 interne Bondverbindungen des zweiten Substrats
- 34 Leiterbahnstruktur
- 5 35 gestrichelte Linie
- A, B,
- C Teile
- d Abstand zwischen dem ersten und zweiten Substrat

Patentansprüche

1. Leistungsmodul mit einem ersten Substrat (1), das mit Leistungshalbleiterchips (4) bestückt ist und einem
5 zweiten Substrat (2), das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückt ist, wobei die Substrate (1, 2) in dem Leistungsmodul (3) parallel übereinander ausgerichtet und ihre Bestückungsseiten (7, 8) zueinander angeordnet sind, und scharnierartig gebogene Bonddrähte (9) die
10 beiden Bestückungsseiten (7, 8) elektrisch miteinander verbinden und den Abstand (d) zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat (1, 2) definieren und mechanisch in einem Kunststoffgehäuse (18) fixieren.
- 15 2. Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Leistungshalbleiterchips (4) bestückte erste Substrat (1) eine Keramikplatte (10) aufweist.
- 20 3. Leistungsmodul nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Leistungshalbleiterchips (4) bestückte erste Substrat (1) eine mehrlagige Keramikplatte (10) aufweist.
- 25 4. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) eine Leiterplatte (11) aus glasfaserverstärktem Kunststoff aufweist.
- 30 5. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) eine mehrlagige Leiterplatte (11) aus glasfaserverstärktem Kunststoff aufweist.

- 5 6. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) Logik-Halbleiterbauteile (12) aufweist.
- 10 7. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) Halbleiterchips (5) mit integrierten Steuerungsschaltungen aufweist.
- 15 8. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) Halbleiterchips (5) mit integrierten Treiberschaltungen aufweist.
- 20 9. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) Halbleiterchips (5) mit Temperatursensoren aufweist.
- 25 10. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückte zweite Substrat (2) Halbleiterchips (5) mit passiven Komponenten, wie Widerständen, Kondensatoren oder Induktivitäten aufweist.
- 30

11. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das mit Leistungshalbleiterchips (4) bestückte erste
5 Substrat (1) Halbleiterchips (4) mit bipolaren Lei-
stungstransistoren mit isoliertem Gate aufweist.
12. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
10 das mit Leistungshalbleiterchips (4) bestückte erste
Substrat (1) Halbleiterchips (4) mit Metalloxid-
Leistungsfeldeffekttransistoren aufweist.
13. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
15 die Leistungshalbleiterchips (4) auf dem ersten Substrat
(1) über Bonddrähte (13) und/oder Leiterbahnen unmittel-
bar auf dem ersten Substrat (1) untereinander und mit
inneren Flachleiterenden (14) von Außenflachleitern (15)
20 verbunden sind.
14. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Signalhalbleiterchips (5) über Leiterbahnen auf dem
25 zweiten Substrat (2) und die scharnierförmig gebogenen
Bonddrähte (9) mit den Leistungshalbleiterchips (4) auf
dem ersten Substrat (1) elektrisch und/oder mit Außen-
flachleitern (15) verbunden sind.
- 30 15. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die scharnierförmig gebogenen Bonddrähte (9) Aluminium
und/oder einer Aluminiumlegierung aufweisen.

16. Leistungsmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die scharnierförmig gebogenen Bonddrähte (9) einen
Durchmesser zwischen 100 und 300 Mikrometern aufweisen.
17. Verfahren zur Herstellung eines Leistungsmoduls (3) mit
einem ersten Substrat (1), das mit Leistungshalbleiter-
chips (4) bestückt ist und mit einem zweiten Substrat
(2), das mit Signalhalbleiterchips (5) bestückt ist, wo-
bei die Substrate (1, 2) in dem Leistungsmodul (3) par-
allel übereinander ausgerichtet und ihre Bestückungssei-
ten (7, 8) zueinander angeordnet sind, und scharnierar-
tig gebogene Bonddrähte (9) die beiden Bestückungsseiten
(7, 8) elektrisch miteinander verbinden und den Abstand
(d) zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat (1, 2)
definieren und mechanisch fixieren, wobei das Verfahren
folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Bereitstellen eines ersten Substrats (1), das mit
Leistungshalbleiterchips (4) bestückt ist und eines
zweiten Substrats (2), das mit Signalhalbleiter-
chips (5) bestückt ist,
 - Ausrichten der beiden Substrate (1, 2), so dass ih-
re Bestückungsseiten (7, 8) nebeneinander angeord-
net sind und Bondflächen (16) aufweisende Randbe-
reiche der Bestückungsseiten (7, 8) beider Substra-
te (1, 2) nebeneinander liegen,
 - Verbinden der Substrate (1, 2) an den Bondflächen
(16) aufweisenden Randbereichen (17) mit Bonddräh-
ten (9), die scharnierförmig nebeneinander angeord-
net werden,
 - Umklappen des zweiten Substrats (2) um 180° unter
Verbiegen der scharnierförmig angeordneten Bond-

drähte (9), so dass die Substrate (1, 2) parallel
übereinander ausgerichtet und ihre Bestückungssei-
ten (7, 8) zueinander angeordnet sind,

- Verpacken des Leistungsmoduls (3) in einem Kunst-
stoffgehäuse (18).

5

18. Verfahren nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Bereitstellen eines ersten Substrats (1) mit Lei-
stungshalbleiterchips (4) eine Keramikplatte (10) mit
einer Leiterbahnstruktur beschichtet wird, die in einem
Randbereich (17) eine Zeile (19) nebeneinander unter
vorgegebenen Rastermaß angeordneter Bondflächen (16)
aufweist, wobei auf dem ersten Substrat (1) die Lei-
stungshalbleiterchips (4) angeordnet werden und unter-
einander sowie mit der Leiterbahnstruktur über Bonddrä-
hte (13) unter Freilassung der Bondflächenzeile (19) ver-
bunden werden und wobei zusätzlich auf der Keramikplatte
(10) innere Flachleiterenden (14) von Außenflachleitern
(15) unter Verbinden mit der Leiterbahnstruktur fixiert
werden.

10

15

20

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Bereitstellen eines zweiten Substrats (2) mit Si-
gnalhalbleiterchips (5) eine Leiterplatte (11) mit einer
Leiterbahnstruktur versehen wird, die in einem Randbe-
reich eine Zeile (20) nebeneinander angeordnete Bondflä-
chen (16) aufweist deren Anzahl und Rastermaß der Bond-
flächenzeile (19) des ersten Substrats (1) entspricht,
wobei auf dem zweiten Substrat (2) die Signalhalbleiter-
chips (5) angeordnet werden und untereinander sowie mit

25

30

der Leiterbahnstruktur über Bonddrähte (13) unter Freilassung der Bondflächenzeile (20) verbunden werden.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
5 dadurch gekennzeichnet, dass
zum Ausrichten der beiden Substrate (1, 2) die Bondflächenzeilen (19, 20) der Substrate (1, 2) nebeneinander
angeordnet werden, so dass Bonddrähte (9) auf den ausgerichteten und zueinander angepassten Bondflächen (16)
10 der beiden Substrate (1, 2) hergestellt werden können.
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbinden der Substrate (1, 2) durch Aufbringen von
15 Bonddrähten (9) zwischen den Bondflächen (16) mittels
Thermokompressions-Sonicbonden von Aluminium- und/oder
Aluminiumlegierungs-Bonddrähten (9) mit einem Durchmesser zwischen 100 und 300 Mikrometern erfolgt.
- 20 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Umklappen des zweiten Substrats (2) um 180° unter
Verbiegen der scharnierförmig angeordneten Bonddrähte
(9), so dass die Substrate (1, 2) parallel übereinander
25 ausgerichtet und ihre Bestückungsseiten (7, 8) zueinander
angeordnet sind mittels eines Vakuumwerkzeugs erfolgt.
23. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
30 dadurch gekennzeichnet, dass
das Verpacken des Leistungsmoduls (3) in einem Kunststoffgehäuse (18) mittels Spritzgußtechnik unter Einbet-

ten der übereinander angeordneten Substrate (1, 2) in eine Kunststoffgehäusemasse (21) erfolgt.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
5 dadurch gekennzeichnet, dass
das Verpacken des Leistungsmoduls (3) in einem Kunststoffgehäuse (18) durch Anordnen der beiden Substrate (1, 2) in einem vorgefertigten Kunststoffgehäuse (22) erfolgt und die Hohlräume (23) zwischen den Substraten
10 (1, 2) und dem vorgefertigten Kunststoffgehäuse (22) mit Siliconmasse (24) aufgefüllt werden.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
15 vor dem Verpacken des Leistungsmoduls (3) in einem Kunststoffgehäuse (18) das erste Substrat (1) auf einer Metallplatte (25) vorzugsweise aus Kupfer oder einer Kupferlegierung als Wärmesenke montiert wird, wobei die Metallplatte (25) eine Außenwand des Kunststoffgehäuses
20 (18) bildet.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Verpacken des Leistungsmoduls (3) in einem
25 Kunststoffgehäuse (18) Außenflachleiter (15) aus dem Kunststoffgehäuse (18) herausragen, die einerseits mit den Leistungshalbleiterchips (4) und andererseits über die scharnierförmig gebogenen Bonddrähte (9) mit den Signalhalbleiterchips (5) elektrisch verbunden sind, wobei
30 als Außenflachleiter (15) für die Leistungshalbleiterchips (4) Außenflachleiter (15) mit einem größeren Querschnitt eingesetzt werden als Außenflachleiter (15) für Signalhalbleiterchips (5).

Zusammenfassung

Leistungsmodul mit mindestens zwei Substraten und ein Verfahren zu seiner Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein Leistungsmodul 3 und ein Verfahren zu dessen Herstellung. Das Leistungsmodul 3 weist ein erstes Substrat 1 mit Leistungshalbleiterchips 4 und ein zweites Substrat 2 auf, das mit Signalhalbleiterchips 5 bestückt ist.

- 10 Die Substrate 1 und 2 sind parallel übereinander ausgerichtet, wobei ihre Bestückungsseiten 7 und 8 zueinander angeordnet sind und wobei das zweite Substrat 2 mit Hilfe scharnierartig gebogener Bonddrähte 9 in einem definierten Abstand d von dem ersten Substrat 1 gehalten und in einem Kunststoffgehäuse 18 mechanisch fixiert und elektrisch verbunden ist.
- 15

[Figur 1]

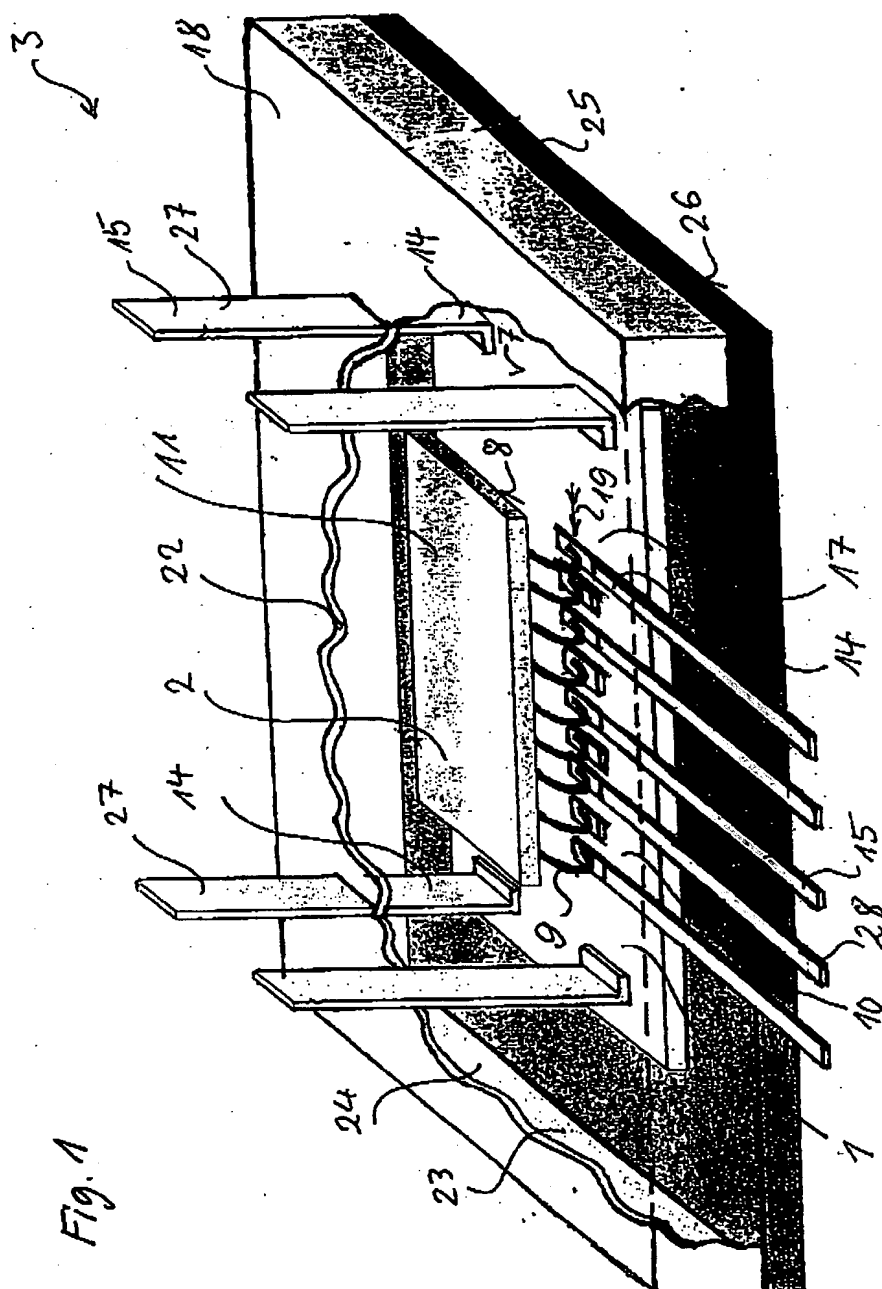


Fig. 1

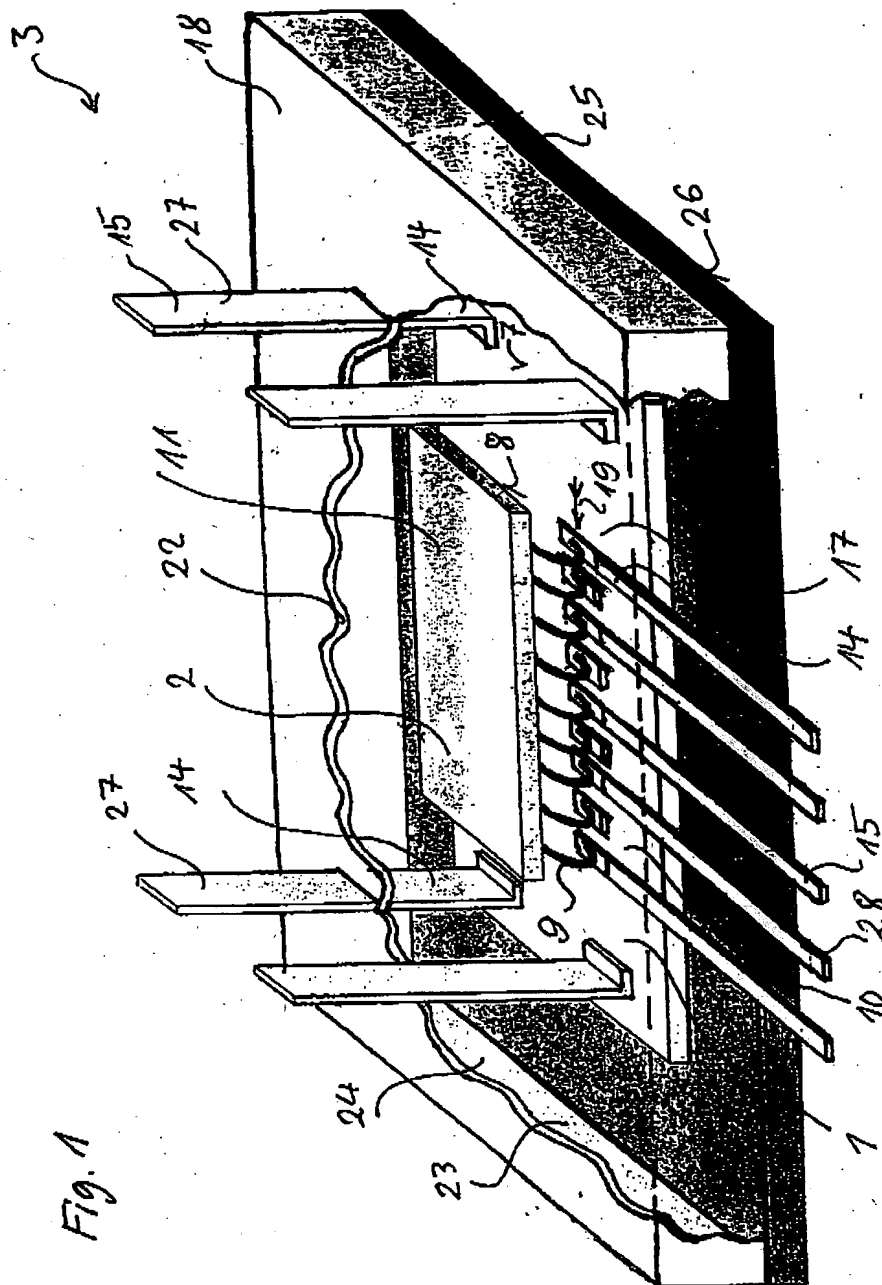


Fig.2

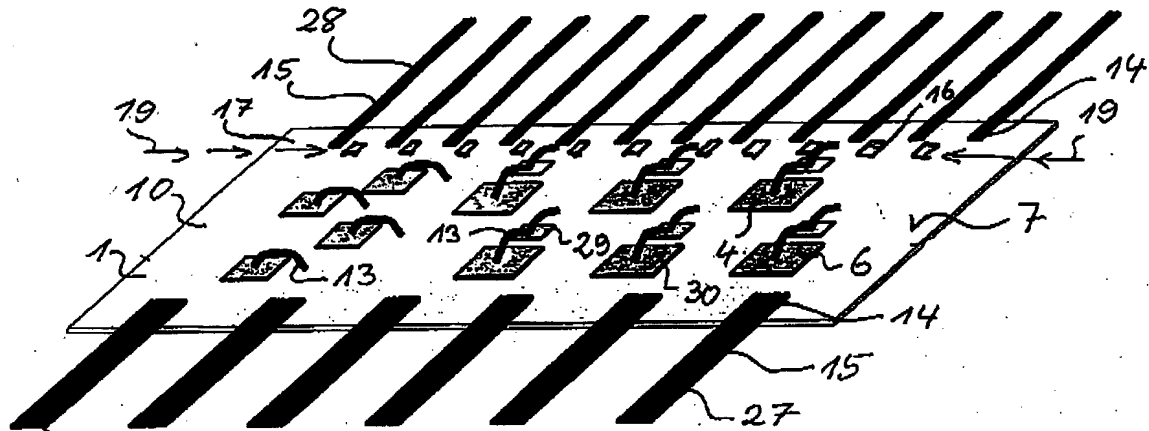


Fig.3

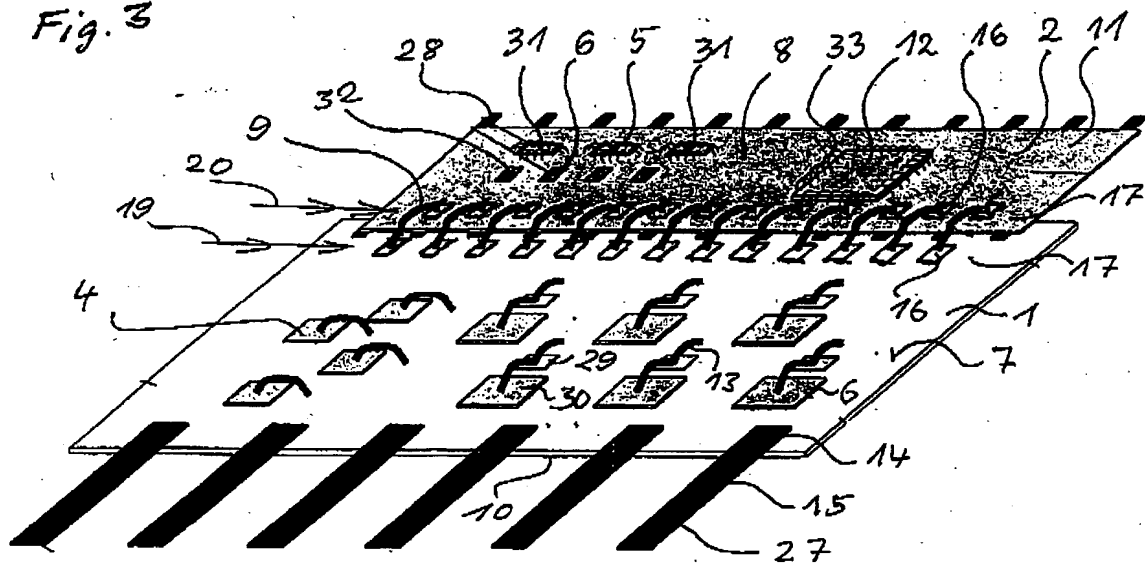


Fig. 4

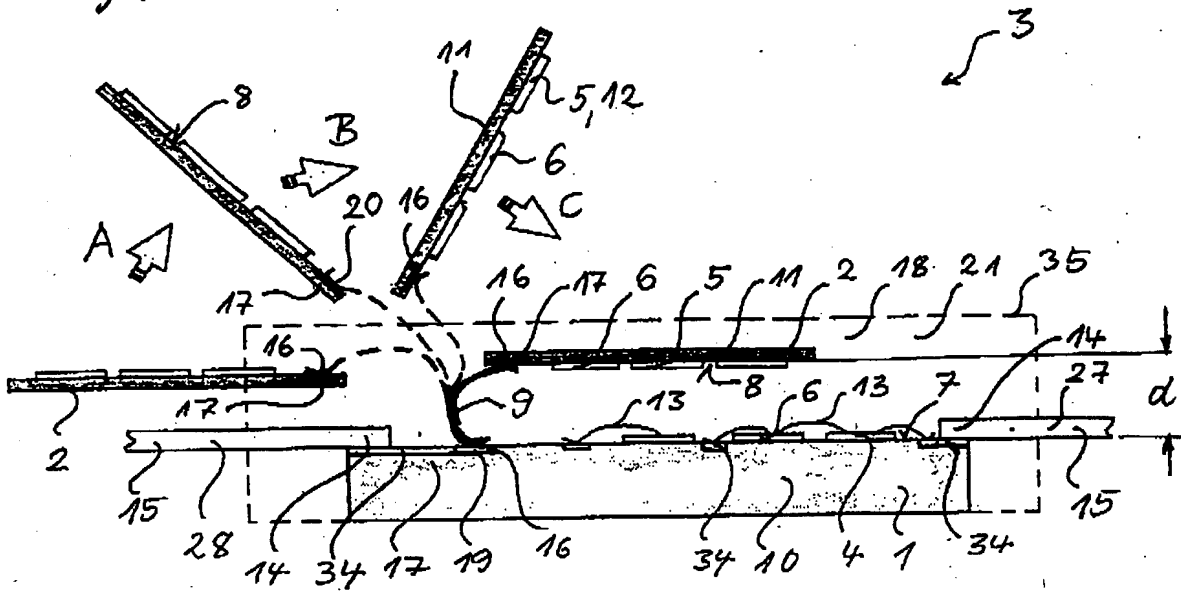
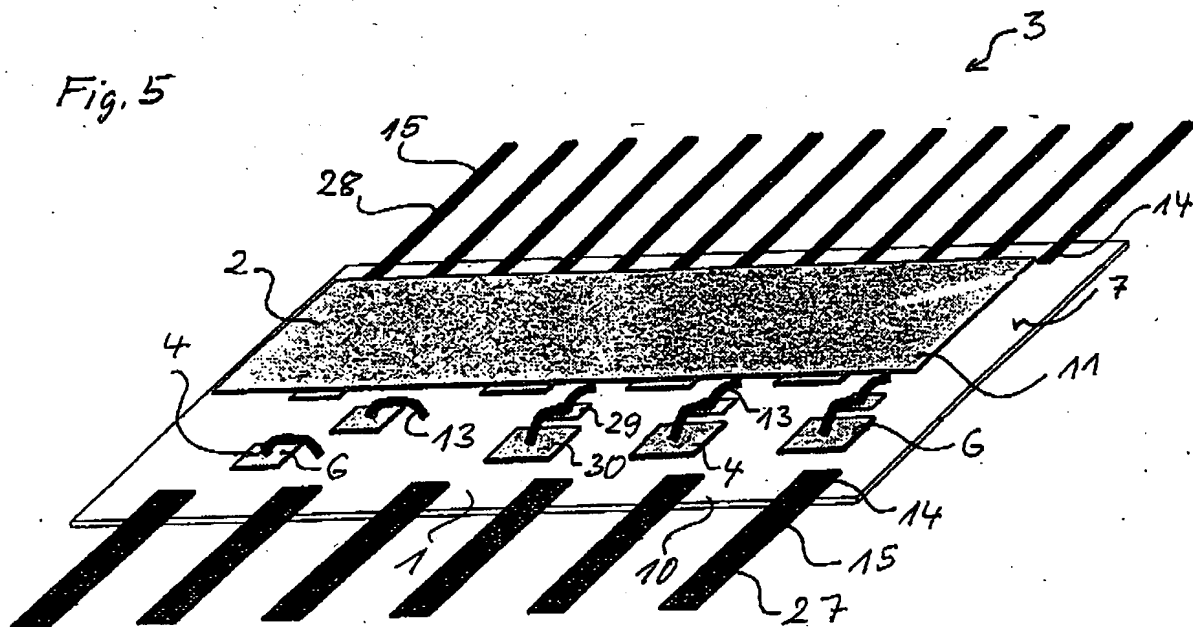
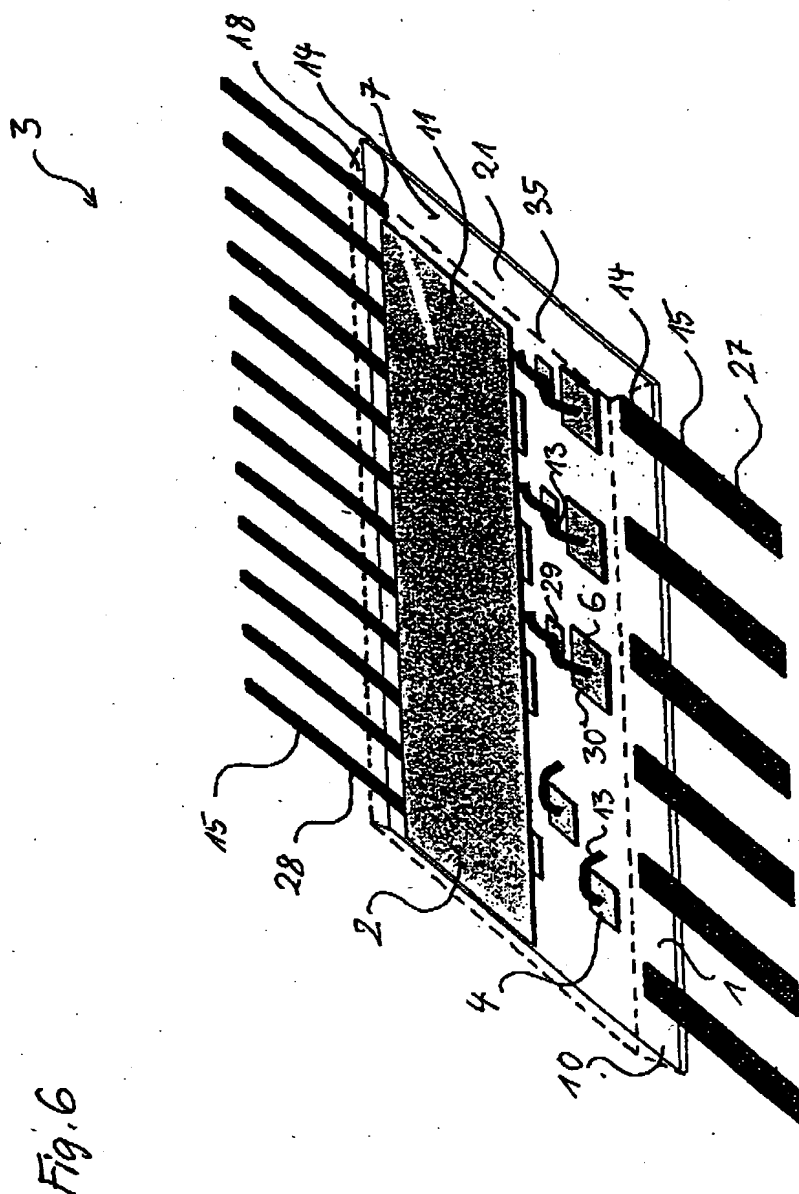


Fig. 5



32



GESAMT SEITEN 32